

КВАНТОВАЯ ХИМИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

УДК 541.572

ВОЗБУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ
ТЕТРАОКСИДА OsO_4 И ТЕТРАОКСОКАТИОНА IrO_4^+

© 2000 г. А. И. Дементьев*, А. В. Зайцевский**, Ю. М. Киселев**

*Московский государственный педагогический университет

**Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет

Выполнены неэмпирические расчеты низколежащих электронных состояний молекулы OsO_4 и изоэлектронного ей иона IrO_4^+ в приближении квазирелятивистского псевдопотенциала. Энергии возбуждений найдены в рамках дифференциальной схемы конфигурационного взаимодействия (полученная энергия возбуждения $35\,045 \text{ см}^{-1}$ для перехода в первое синглетное состояние OsO_4 хорошо согласуется с экспериментальным значением $35\,000 \text{ см}^{-1}$).

Информация о низших электронных состояниях молекулы OsO_4 и тетраоксоиона IrO_4^+ важна для интерпретации существующих экспериментальных данных и для оценки вероятности получения соединений иридия в высших степенях окисления. Молекула OsO_4 интенсивно изучалась как экспериментально, так и теоретически. В работе [1] были выполнены расчеты характеристики ее основного электронного состояния в рамках одноэлектронного приближения. Неэмпирические расчеты возбужденных электронных состояний обсуждаемых систем на высоком неэмпирическом уровне ранее не проводились. Так как молекула OsO_4 легко может быть получена в газовой фазе и ее спектр лежит в доступной для проведения эксперимента области, она является одной из немногих тетраэдрических систем, в спектре поглощения которых удалось наблюдать и проанализировать дискретные системы полос.

Впервые спектр поглощения OsO_4 был получен Лифшицем и Розенбомом [2, 3] и подробно исследован Лангсетом и Квиллером [4]. Наблюдаемые в спектре полосы были отнесены к трем системам, 0–0-переходы которых расположены при 33388 , 36225 и 38101 см^{-1} соответственно. Всего было обнаружено 17 групп полос в области 3200 – 2200 \AA . Более детальный спектр поглощения OsO_4 был записан Веллом с соавторами [5]. Сложный характер спектра затруднил его интерпретацию. В частности, была отмечена возможность присутствия в спектре множества “горячих” линий и большая вероятность появления в основном электронном состоянии резонансов Ферми и Кориолиса, так как $v_2 \equiv v_4$ и $3v_4 \equiv v_1, v_3$. В дополнение к этому необходимо учесть наложение на спектр вращательной структуры. Авторы пришли к заключению, что из системы полос

в области 31261 – $45\,596 \text{ см}^{-1}$ нельзя получить достоверную информацию об эффекте Яна–Теллера вырожденного возбужденного электронного состояния OsO_4 , которое было отнесено к неприводимому представлению T_2 группы тетраэдра. В спектре также были обнаружены три очень слабые системы полос, и было высказано предположение, что если они относятся к синглет–триплетным переходам, то спин–орбитальное взаимодействие должно быть слабым и не превышать величин, типичных для молекул с легкими атомами. В 1973 г. Фостер и др. [6] получили спектр OsO_4 в матрице SF_6 . По матричным сдвигам, а также с помощью данных фотоэлектронной спектроскопии они отнесли две первые наиболее интенсивные полосы с максимумами поглощения $35\,000$ и $42\,000 \text{ см}^{-1}$ к переходам с занятых молекулярных орбиталей (МО) t_2 и t_1 на первую виртуальную МО симметрии e . В этой работе были также отнесены полосы, отвечающие более высоким энергиям. Сложная структура полос ассоциировалась с электронно–колебательным взаимодействием. Такое отнесение было впервые подтверждено теоретически Вистом и Греем [7] на основе аналогии с электронной структурой иона MnO_4^- . В работе [8] электронная оболочка OsO_4 была рассчитана методом X_α в приближении дискретного варьирования (X_α -ДВМ). Энергии электронных переходов оценивались по разности одиночественных энергий в приближении переходного состояния; полученное значение энергии вертикального синглет–синглетного электронного перехода почти на $10\,000 \text{ см}^{-1}$ отличается от экспериментальной величины (см. таблицу). Такое расхождение между расчетной и экспериментальной величинами не удивительно, так как в этой работе не

учитывалось много факторов, существенных для точности расчета:

1) степень учета релятивистских поправок (использование нерелятивистского приближения должно сильно завысить равновесные межъядерные расстояния в OsO₄);

2) качество приближения для коррелированной волновой функции;

3) электронно-колебательные взаимодействия в первом возбужденном вырожденном электронном состоянии (эффект Яна–Теллера первого порядка).

В данной работе мы на примере расчета первого синглет–синглетного электронного перехода (¹T₂–¹A₁) для молекулы OsO₄ попытались выяснить можно ли, используя современный уровень квантово-механических расчетов, дать оценку этой величины для тяжелых молекул с достаточной надежностью.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Адекватное описание электронного строения соединений элементов II переходного ряда невозможно без последовательного учета релятивистских эффектов. В нашем расчете воспроизведение так называемых скалярных релятивистских эффектов достигалось путем использования усредненных по спину релятивистских оставочных потенциалов. Спин-орбитальное взаимодействие игнорировалось, так как косвенные спектроскопические данные и расчетные значения расщеплений одноэлектронных уровней [8, 9] указывают на то, что их вклад в энергии изучаемых переходов не должен превышать 1000 см⁻¹. К оставным были отнесены электронные оболочки 1–4s, 2–4p, 4f осмия (иридия), а также – из соображений сбалансированности расчетной схемы – 1s-оболочки атомов кислорода. Таким образом, явно описывалась зависимость волновых функций от координат 40 электронов. Релятивистские псевдопотенциалы были взяты из работ [10, 11].

Детальный анализ корреляции столь большого числа электронов в рамках стандартных вариантов метода конфигурационного взаимодействия (КВ) с несколькими исходными конфигурациями (НИК) чрезвычайно трудоемок и вряд ли целесообразен вследствие возможных отклонений от размерной согласованности. Поэтому мы обратились к принципу организации процедуры КВ, непосредственно ориентированному на воспроизведение энергий переходов (дифференциальная схема КВ [12, 13]). В его основе лежит то обстоятельство, что значительная часть базисных слейтеровских детерминантов вносит почти одинаковые вклады в энергию исходного и конечного состояний.

Энергии (ΔE) вертикальных электронных переходов молекулы OsO₄ и ионов IO₄⁺

Система и переход	ΔE , см ⁻¹	Метод расчета
OsO ₄ (¹ T ₂ – ¹ A ₁)	26939	X _α -ДВМ [10]
	33700	оценка [1]
	33029	MCSCF (базис ‘min’)
	31245	ДКВ (базис ‘min’)
	35045	ДКВ (базис ‘max’)
	35000	эксперимент [5, 6]
OsO ₄ (¹ T ₂ – ³ A ₁)	11049	X _α -ДВМ [10]
	32416	ДКВ (базис ‘max’)
IO ₄ ⁺ (¹ T ₂ – ¹ A ₁)	24820	оценка [1]
	28336	MCSCF (базис ‘min’)
	22993	ДКВ (базис ‘max’)

Среди одночастичных функций (МО) выделяются поднаборы активных МО (т.е. тех, числа заселенности которых для разных исходных конфигураций могут отличаться), инактивных и вторичных МО (соответственно двухкратно занятых и вакантных во всех исходных конфигурациях). Далее базис слейтеровских детерминантов формируется при помощи одно- и двухчастичных возбуждений исходных конфигураций, исключая переносы двух электронов с инактивных на вторичные МО (инактивные двухкратные возбуждения). В практике расчетов по стандартной схеме КВ НИК 1 + 2 именно такие возбуждения часто порождают подавляющее большинство многоэлектронных базисных функций. Вместе с тем несложные оценки во втором порядке многочастичной теории возмущений показывают, что их вклады в энергию перехода должны быть малы; напротив, вклады таких детерминантов в величину отклонения вариационных методов от размерной согласованности могут быть значительными. Применение процедуры отбора [14] к оставшейся совокупности детерминантов позволило понизить размерность задачи КВ до 10⁵, тогда как размерность соответствующей проблемы КВ НИК 1 + 2 составила бы 10⁹. Базисные молекулярные виртуальные орбитали находились как решения хартри–фоковских уравнений для молекулярного иона с дробными заселеностями валентных и низших виртуальных МО. В расчетах методом дифференциального КВ (ДКВ) “активными” считались верхние занятые МО 3a₁, 4t₂, 1t₁ и первые виртуальные МО 2e, 5t₂, 4a₁ (всего 14 орбиталей). Вычисления проводились с описанием симметрии при помощи абелевой подгруппы C_{2v} группы тетраэдра.

Для выяснения устойчивости результатов по отношению к выбору одночастичного базиса была проведена серия расчетов, в которых базисные

наборы сгруппированных гауссовых функций последовательно расширялись от $(8s7p6d)/[6s5p3d]$ Os (Ir) и $(4s5p)/[2s2p]$ O (базис 'min') [10, 11] до $(8s7p6d2f)/[6s5p4d2f]$ Os (Ir), $(5s5p2d)/[3s3p2d]$ O (базис 'max'). Значения экспоненциальных множителей составляли 0.505 и 1.35 для f -функций на Os (Ir) и 1.5 и 0.5 d -функций кислорода.

Расчеты проводились при межъядерных расстояниях $r(\text{Os}-\text{O}) = 1.697 \text{ \AA}$ (экспериментальное значение 1.71 \AA [15]), $r(\text{Ir}-\text{O}) = 1.76 \text{ \AA}$, найденных в хартри-фоковском приближении с последующим учетом корреляции во втором порядке теории возмущений Мёллера–Плессета [1].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Валентная электронная оболочка OsO_4 (IrO_4^+) по данным расчетов методом ССП выглядит следующим образом: $1a_1^2 1t_2^6 2t_2^6 2a_1^2 3t_2^6 1e^4 3a_1^2 4t_2^6 1t_1^6$. Порядок следования одночастичных энергий совпадает с полученным в приближении X_α -РВ. Расчитанные нами и известные из публикаций энергии электронных переходов приведены в таблице. Прежде всего отметим, что вычисленные на уровне ДКВ (базис 'max') энергии переходов практически не меняются при расширении базисной системы функций, замене набора MO и при дальнейшем расширении размерности диагонализируемой матрицы гамильтонiana. Таким образом, можно надеяться, что нам удалось практически исключить при расчетах ошибки, связанные с выбором базиса и степенью учета корреляции. Если учесть, что, как уже отмечалось, погрешность связанный с пренебрежением спин-орбитальным взаимодействием, мала и использованные псевдопотенциалы достаточно надежны (судя по результатам расчетов атомных спектров), то рассчитанные энергии переходов исследуемых систем получены с достаточной степенью достоверности. Рассчитанные нами значения электронных переходов молекулы OsO_4 существенно отличаются от значений, найденных ранее в приближении X_α -ДВМ [10]. Для первого электронного перехода в синглетное состояние, теоретическая энергия полностью совпадает с энергией в максимуме первой полосы поглощения (35045 и 35000 cm^{-1} соответственно).

Полученная величина энергии запрещенного по спину электронного перехода тетраоксида осмия (32146 cm^{-1}) указывает на тот факт, что этот переход также может вносить вклад в низкоэнер-

гетическую слабоинтенсивную часть первой полосы поглощения этой молекулы. Полученные энергии переходов хорошо согласуются с выполненными ранее Ю.М. Киселёвым оценками этих величин на основе анализа и интерполяции экспериментальных данных различных тетраоксидов металлов. К сожалению, мы не смогли учесть электронно-колебательные взаимодействия в вырожденном первом синглетном состоянии OsO_4 , которые, по всей видимости, и определяют структуру первой полосы поглощения. Заметим также, что ведущие конфигурации в волновых функциях изученных возбужденных электронных состояний отвечают однократно заселенным MO $3t_2$ и $2e$, что согласуется с принятым отнесением [16] этих переходов, хотя вклад конфигураций с более высокими возбуждениями весьма существенен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дементьев А.И., Кузнецов М.Л., Киселев Ю.М. // Журн. неорган. химии. 1997. Т. 42. № 7. С. 1167.
2. Lifschitz J., Rosenbohm E. // Z. Phys. Chem. 1921. B. 97. S. 1.
3. Kato S. // Sci. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 1930. V. 13. P. 248.
4. Langseth A., Qviller B. // Z. Phys. Chem. 1934. B. 27B. S. 79.
5. Wells E.J., Jordan A.D., Alderdice D.S., Ross I.G. // Aust. J. Chem. 1967. V. 20. P. 2315.
6. Foster S., Jordan A.D., Alderdice D.S., Ross I.G. // Ibid. 1973. V. 95. P. 6578.
7. Viste A., Gray B.B. // Inorg. Chem. 1964. V. 3. № 8. P. 1113.
8. Тополь И.А., Вовна В.И., Казачек М.В. // Теорет. и эксперим. химия. 1987. № 4. С. 456.
9. Burstain B.E., Green J.C., Kaltsoyannis N. // Inorg. Chem. 1994. V. 33. P. 2315.
10. Rauk A., Ziegler T., Ellis D.E. // Theor. Chim. Acta. 1974. V. 34. P. 49.
11. Andrae D., Haussermann U., Dolg M. et al. // Ibid. 1990. V. 77. P. 123.
12. Schwerdtfeger P., Dolg M., Schwarz W.H.E. et al. // J. Chem. Phys. 1989. V. 91. P. 1762.
13. Miralles J., Gastell O., Caballol R., Malrieu J.-P. // Chem. Phys. 1993. V. 172. P. 33.
14. Garsia V.M., Gastell O., Caballol R., Malrieu J.-P. // Chem. Phys. Letters. 1995. V. 238. P. 222.
15. Spiegelmann F., Malrieu J.P. // J. Phys. B: At. Mol. Phys. 1984. V. 17. P. 433, 1259.
16. Молекулярные постоянные неорганических соединений / Под ред. К.С. Краснова. Л.: Химия, 1979.